

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60065712 A

(43) Date of publication of application: 15 . 04 , 85

(51) Int. CI

C01B 33/113 // B01J 19/12

(21) Application number: 58172222

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(22) Date of filing: 20 , 09 , 83

(72) Inventor.

HAYAMA NORIYUKI YUGE YOJI

WATANABE TSUTOMU ISHIZAKI ARIYOSHI

- (54) FORMATION OF SILICON OXIDE COATING FILM
- (57) Abstract:

PURPOSE: A substrate is corted with an organosilicon compound contraining ultra-violet absorbing substances and sintered in an oxidative atmosphere as ultraviolet rays are irradiated to effect oxidation whereby good coeting films of silicon oxide are formed at relatively low temperatures.

CONSTITUTION. A substrate is coated with an

organositicon compound containing an ultraviolet absorbing substance such as an organotitanium compound and placed in a heating furnace, then baked in an excitative stroosphere at about 250°C, as ultraviolet rays are irradiated to exidize the organositicon compound and form coating films of elicon exide on the substrate. Thus, sifecon exide coating films used as optical interference films with high reiractive index.

The state of the state of the state of

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

Ħ

⑭日本国特許庁(JP)

卯特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 阳

昭60-65712

@Int_Cl_4

做別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)4月15日

C 01 B 33/113 # B 01 J 19/12 7059-4G 6542-4G

零査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 酸化けい素被膜の形成方法

砂特 顧 昭58-172222

魯出 顧 昭58(1983)9月20日

砂発 明 者 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 叢 Ш 賀工場内 砂発 明 者 弓 削 釬 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 砂発 明 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 渡 辺 カ 賀工場内 00発明 横須賀市船越町1の201の1 東京芝削電気株式会社横須 石 義 賀工場内

创出 關 人 株 式 会 社 東 芝

80代 理 人 弁理士 井上 一男

川崎市幸区堀川町?2番地

明 和 春

1. 発明の名称

酸化けい素被膜の形成方法

2. 特許請求の範囲

(1) 兼外線級収性物質を含む有根けい案化合物を 基件に監布し、そののち酸化性雰囲気中にかいて 繋外線で無射しながら続成して上記有根けい業化 合物を酸化して酸化けい業からなる被膜に形成す ることを毎数とする酸化けい素被膜の形成方法。 (2) 紫外線吸収性物質は有根金属化合物であると とを特数とする特許請求の範囲第1項記載の酸化

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

けい象被膜の形成方法。

本発明は酸化けい素被膜の形成方法の改良に関する。

〔発明の技術的背景とその問題点〕

取化けい素薄膜は安定で低脂折率でしかも設厚を任念に形成できることにより、光学薄膜として古くから利用されている。また、近年に乗り、彼

品セル用ガラス板のナトリウム海出勧止駅とて多用されるようになつた。とのようを破化けい実被 鉄の形成方法として、従作、真空薫燈法、スペッ メ法、化学的気相析出法をどが知られているが、 これらの方法はいずれも調査後近が複様で作業性 にも離点があつた。

との方法は装置が関係で、作業性が良く、大面数の基体や複雑な形状の基体にも形成が容易であ

E

る。しかし、その反面、強固で安定な底を得るためには、700℃以上の高級で焼成することが必要で、エオルギ的に問題があつた。

(発明の目的)

本発明は比較的低温で鈍成できる酸化けい業績 裏の形成方法を提供することを目的とする。

(発明の紙要)

有限けいま化合物に無外線吸収物質を能加して 基体に集布し、酸化性雰囲気中にかいて兼外線を 脈射しながら铣成することにより、有扱けい素化 合物に良く紫外線を吸収させ、その光化学作用に よつて比較的低温で有機けい素化合物を硬化して 良好主酸化けい素被額を形成するものである。 〔発明の実施例〕

限化けい素薄膜と酸化チタン薄膜とを4層づつ 交互重層してなる光干浄膜の形成を例にして説明 する。

8i0. 換算で10重量すのけい需要含む有機けい 常化合物需収に、Ti: 8i(原子比)=3.5:100 の有根テタン化合物たとえばアルコキンドを採加 **発息時 60- 65712(2)**

し、前一に混合した。との混合欲に症状ガラス益 体を役債し、180四/分の速度で引上げて危布 した。ついて、100W定格高圧水鉄ランプ4本 を装備した常外数炉に入れて空気容配気で焼成を 行立つた。との伊は紫外藤強変 300mW/皿、 穏 度350℃が得られるものである。この焼成Kよ つて基体に豊布した有扱けい家化合物は単数では 2537mm以上の中放長かよび長放長の繁外線を行 とんど吸収したいにもかかわらず、有機チタン化 合物の共存によつて常外額を良く吸収するように なり、その光化学作用によつて有機けいま化合物 かよび有限チョン化合物の両者とも350℃とい り比較的低温であるにもかかわらず、完全に限化 されて小量の歌化チタンが個人した酸化けい涙か ちなる複膜に形成された。ちなみに、この位化け い業専践の数厚は1300%で、組折率は1.50で

つぎに、との敗化けい黒難談を形成した基体を TiOs 換算で 6 重量 5 の有級チメン 化合物などえば アルコキンドの液に便渡し、2 2 0 mm / 分の最近

で引上げ、上述の酸化けい素率膜形成のときと同様な条件で検収し、酸化チタン群膜に形成した。 ちを分化、との酸化チタン構模の原序は 1500 Å で、屈折率は 2.15 であつた。

そりして、以上の操作をそれぞれ4回交互に繰返すととにより8階が重層してなる光干砂膜が形成された。

この光干夢数は基体全面にわたり、所建の光学特性を有し、その特性分布も均一であつた。ちなみに、その光学特性を配に示す。別は狭軸に放展を #m の単位でとり、貨軸に光透過率かよび光反射率をいずれも # の単位でとつたもので曲触 W (実験で示す。)は透過率、曲線四(破骸で示す。)は反射率をそれぞれ示す。

をお、船通の実施倒に対し、比較のため、有扱けい常化合物に有機チタン化合物を感加することなく用い、前述と同様にして光干砂線を形成したところ、4~5届目で膜全体に利服が生じた。この理由は飛化けい素薄膜形成に戻し、有機けい常化合物の一部が充分に類化分がしないまま独留し、

しかして、無外額級収性物質の認加量は多い任 ど有機けい業化合物の硬化分解が良くなるが、た とえばチタンの場合には得られた硬化けい素が駅 の原折率を上昇させるので、光干部段として用い る場合にはかのづから低加量が制度される。他の 無外額吸収性物質にも低加量を展定する場合がある。

また、衆外離吸収性物質として有限メンタル化

会物を使用できる。との場合、は化タンタルは母化ナタンと比較して紫外線の長収帯が高千極故長似ヘンフトしているが、それでも300m以下の紫外線に長収帯があるので適当を被長級の紫外線を用いればよい。また、股化タンタルの副新本は酸化テタンのそれより低く、酸化けい紫膜へが出る。また、焼成条件にもよるが、可視光透過率の向上も計りあい。そして得られた股化けい紫膜の酸化タンタル混入率がTe:8i(原子比)で5:100の場合屈折率が1.50で10:100の場合屈折率が1.53であつた。また、腹の鉄脂性も良好であった。

また、被晶セル用ガラス板のナトリウム溶出防止用酸化けい素被膜の形成の場合も前述と同様にして実施できる。そうして、酸化けい素被膜の膜 厚は従来技術と同様にして任意に形成できる。

また、本発明だかいて使成雰囲気は空気に取らず、空気または窒素をどに酸素。オプンなどを適宜が加して酸化能を調整した気体でもよい。さらに、有限けい素化合物の歯布方法は任意である。

特別報 60- 65712 (3)

さられ、基件の対質、形状、大小あるいはその 用途については制限はをい。

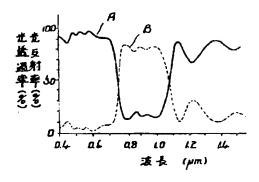
(発明の効果)

本発明の政化被膜の影成方法は無外翻吸収性物質を緩加した有機けい素化合物を高体に染むし、 酸化性雰囲気中にかいて無外部限制しなから焼成 して有機けい素化合物を酸化し娘化けい素から焼成 して有機に形成したので、無外縁の充化学作用によ る被膜に形成したので、無外縁の充化学作用によ つて比較的低温でも度好に有優けい素化合物を成 化分解することができ、焼成エネルギ節約に设立 つ。

4. 国面の簡単な説明

図は本乳明の取化けいま被説の形成方法の一実 集例を適用して得られた光干部設の一例の光学特 性を示すグラフである。

代继人 弁理士 井 上 一 男



Ė